

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

This is to certify that the annexed is a true copy
of the following application as filed with this office.

Date of Application: June 19, 2003

Application Number: No. 2003-174748
[ST.10/C] : [JP 2003-174748]

Applicant(s) MITSUMI ELECTRIC CO., LTD.

January 7, 2004

Commissioner,
Japan Patent Office

Yasuo Imai (Seal)

Certificate No.2003-3109231

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 6月19日
Date of Application:

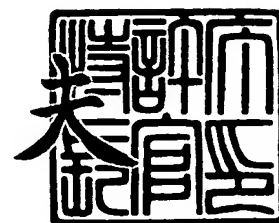
出願番号 特願2003-174748
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP 2003-174748]

出願人 ミツミ電機株式会社
Applicant(s):

2004年 1月 7日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康



【書類名】 特許願

【整理番号】 07X12504-0

【提出日】 平成15年 6月19日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 H01L 23/00

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県厚木市酒井 1 6 0 1 ミツミ電機株式会社厚木
 事業所内

 【氏名】 脇 直純

【特許出願人】

 【識別番号】 000006220

 【氏名又は名称】 ミツミ電機株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100070150

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 伊東 忠彦

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 002989

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体集積回路装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数系統の高周波信号を入出力する半導体集積回路装置において、

前記高周波信号を入出力する第 1 外部端子の間に前記第 1 外部端子より高インピーダンスの第 2 外部端子を配置し、

前記第 2 外部端子に一端を接続され他端を所定電位とされた容量素子を設けたことを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項 2】 請求項 1 記載の半導体集積回路装置において、

前記第 2 外部端子は、D 映像端子接続確認用または D 映像端子判別用の外部端子であることを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項 3】 請求項 1 記載の半導体集積回路装置において、

前記第 2 外部端子は、S 映像端子接続確認用または S 映像端子判別用の外部端子であることを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項 4】 請求項 1 乃至 3 のいずれか記載の半導体集積回路装置において、

前記高周波信号は、映像信号であることを特徴とする半導体集積回路装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は半導体集積回路装置に関し、特に、複数系統の高周波信号を入出力する半導体集積回路装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

映像信号等の高周波信号を入出力する半導体集積回路装置では、半導体集積回路の外部端子間の浮遊容量の影響により、高周波信号を入出力する外部端子間のクロストークが問題となる。このため、通常は高周波信号を入出力する 2 つの外部端子間に電源 V_{cc} の外部端子や接地 GND の外部端子のような低インピーダ

ンスの外部端子を配置している。

【0003】

図6は、従来の半導体集積回路装置の一例の平面図を示す。同図中、半導体集積回路装置本体10の外周縁には複数の外部端子12a～12xが設けられている。このうち、外部端子12a, 12c, 12eは映像信号が入力または出力する外部端子である。外部端子12a, 12c間の外部端子12bは電源Vccを入力する外部端子とされ、外部端子12c, 12e間の外部端子12dは接地GNDを入力する外部端子とされている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

半導体集積回路装置に入出力する映像信号の数（系統数）が増加した場合、電源Vccや接地GNDのような低インピーダンスの外部端子数が不足し、不足分だけ低インピーダンスの外部端子を追加しなければならず、外部端子数が増加するという問題があった。また、映像信号の外部端子間に低インピーダンスの外部端子を配置するために、外部端子の配置の自由度が低いという問題があった。

【0005】

本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、低インピーダンスの外部端子数を増加することなくクロストークを低減できる半導体集積回路装置を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】

請求項1に記載の発明は、複数系統の高周波信号を入出力する半導体集積回路装置において、

前記高周波信号を入出力する第1外部端子（222, 224, 226, 228, 2210, 2212）の間に前記第1外部端子（222, 224, 226, 228, 2210, 2212）より高インピーダンスの第2外部端子（225, 227, 229, 2211）を配置し、

前記第2外部端子（225, 227, 229, 2211）に一端を接続され他端を所定電位とされた容量素子を設けたことにより、

高周波信号を入出力する第1外部端子(222, 224, 226, 228, 2210, 2212)の間のクロストークを低減することができ、かつ、低インピーダンスの外部端子の増加を防止できる。

【0007】

請求項2に記載の発明では、第2外部端子(225, 227, 229, 2211)は、D映像端子接続確認用またはD映像端子判別用の外部端子であることにより、請求項1の発明を実現できる。

【0008】

請求項3に記載の発明では、第2外部端子(225, 227, 229, 2211)は、S映像端子接続確認用またはS映像端子判別用の外部端子であることにより、請求項1の発明を実現できる。

【0009】

なお、上記括弧内の参照符号は、理解を容易にするために付したものであり、一例にすぎず、図示の態様に限定されるものではない。

【0010】

【発明の実施の形態】

図1は、本発明の半導体集積回路装置の一例の平面図を示す。同図中、半導体集積回路装置本体20の外周縁には複数の外部端子221～22nが設けられている。このうち、外部端子222, 224, 226, 228, 2210, 2212は映像信号が入力(または出力)される外部端子である。

【0011】

外部端子221は電源Vccを入力する外部端子とされ、外部端子222, 224間の外部端子223は接地GNDを入力する外部端子とされている。また、電源Vccを入力する外部端子とされ、外部端子224, 226間の外部端子225はD端子接続確認用の外部端子、外部端子226, 228間の外部端子227及び外部端子228, 2210間の外部端子229及び外部端子2210, 2212に隣接する外部端子2211それぞれはD端子判別用の外部端子とされている。

【0012】

なお、「D端子」は「D映像端子」を略した一般的な呼び方であり、D端子接続確認用の外部端子225は、D端子ケーブルが接続されると接地GNDの外部端子と短絡されることで、D端子ケーブルの接続有無を検出する。D端子判別用の外部端子227, 229, 2211は、それぞれの電圧が5Vか2.2Vか0Vかによって映像フォーマットとアスペクト比を識別する。つまり、外部端子225, 227, 229, 2211は直流電圧が検出できれば良い。

【0013】

図2は、本発明の半導体集積回路装置の内部でD端子接続確認用またはD端子判別用の外部端子225, 227, 229, 2211が接続されるインターフェース回路の一実施例の回路図を示す。同図中、外部端子30にはダイオードD1のアノード、ダイオードD2のカソード、pnpトランジスタQ1のベース及びコンデンサC1の一端が接続されている。

【0014】

ダイオードD1のカソードは電源Vccに接続され、ダイオードD2のアノードは接地されている。トランジスタQ1のエミッタは定電流源32を介して電源Vccに接続されており、このエミッタ出力が後続回路に供給される。コンデンサC1の他端は接地されている。

【0015】

従来はコンデンサC1が設けられておらず外部端子30は高インピーダンス（直流抵抗略100kΩ）であったが、コンデンサC1（例えば静電容量10pF）を設けたことにより、外部端子30に供給される映像信号に対し低インピーダンスとされている。D端子接続確認用及びD端子判別用の外部端子221, 227, 229, 2211では、外部端子30は開放または所定の直流電圧を印加された状態で使用される。従って、外部端子30にコンデンサC1を接続して低インピーダンス化しても何ら問題はない。

【0016】

図3は、本発明の半導体集積回路装置の内部で映像信号入力用の外部端子222, 224, 226, 228, 2210, 2212が接続されるインターフェース回路の一実施例の回路図を示す。同図中、外部端子40にはダイオードD11

のアノード、ダイオードD12のカソード、npnトランジスタQ12のベース及び抵抗R1の一端が接続されている。

【0017】

ダイオードD11のカソードは電源Vccに接続され、ダイオードD12のアノードは接地されている。抵抗R1の他端はnpnトランジスタQ11のエミッタ及び抵抗R2の一端に接続され、抵抗R2の他端は接地されている。トランジスタQ11はコレクタを電源Vccに接続され、ベースには定電圧源42から所定電圧が印加されている。

【0018】

トランジスタQ12のコレクタは抵抗R3を介して電源Vccに接続され、トランジスタQ12のエミッタはnpnトランジスタQ13のベースに接続されている。トランジスタQ13はベース・エミッタ間を抵抗R4で接続され、コレクタは電源Vccに接続され、エミッタは定電流源44を介して接地されており、このエミッタ出力が後続回路に供給される。外部端子40のインピーダンスは直流抵抗75Ωである。

【0019】

図4は、本発明の半導体集積回路装置の外部端子の等価回路図を示す。同図中、外部端子22gに映像信号が入力される。外部端子22g, 2210それぞれの直流抵抗Ra, Rbは75Ωであり、外部端子22gの直流抵抗Rcは100kΩであり、外部端子22gは静電容量10pFのコンデンサC1を介して接地されている。外部端子22g, 22g間には浮遊容量Caが存在し、外部端子22g, 2210間には浮遊容量Cbが存在する。なお、Ca, Cbの静電容量は略0.5pFである。

【0020】

この場合、外部端子22gから外部端子2210に漏れる高周波信号のクロストークを図5に実線で示す。図5においては、周波数略30MHz以下でクロストークは-70dB以下となり、最大周波数が30MHzである映像信号のクロストークはほとんど無視できる。これに対し、外部端子22gのコンデンサC1を削除した場合、外部端子22gから外部端子2210に漏れる高周波信号のク

ロストークは図 5 に破線で示すように、周波数 3.5 MHz 以上でクロストークが -70 dB を超え、映像信号のクロストークは無視できない。

【0021】

なお、上記実施例では、D 映像端子を例に説明したが、半導体集積回路装置 20 が S 映像端子を持つ場合も、映像信号が入力（または出力）される外部端子の他に、S 端子接続確認用の外部端子と S 端子判別用の外部端子があるので、これら S 端子接続確認用と S 端子判別用の外部端子を映像信号が入出力される外部端子の間に配置し、S 端子接続確認用と S 端子判別用の外部端子それぞれにコンデンサを設け低インピーダンス化しても良く、上記実施例に限定されない。

【0022】

【発明の効果】

上述の如く、請求項 1 に記載の発明は、高周波信号を入出力する第 1 外部端子の間に前記第 1 外部端子より高インピーダンスの第 2 外部端子を配置し、第 2 外部端子に一端を接続され他端を所定電位とされた容量素子を設けたことにより、高周波信号を入出力する第 1 外部端子の間のクロストークを低減することができ、かつ、低インピーダンスの外部端子の増加を防止できる。

【0023】

また、請求項 2 に記載の発明では、第 2 外部端子は、D 映像端子接続確認用または D 映像端子判別用の外部端子であることにより、請求項 1 の発明を実現できる。

【0024】

また、請求項 3 に記載の発明では、第 2 外部端子は、S 映像端子接続確認用または S 映像端子判別用の外部端子であることにより、請求項 1 の発明を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の半導体集積回路装置の一例の平面図である。

【図 2】

本発明の半導体集積回路装置の内部で D 端子接続確認用または D 端子判別用の

外部端子が接続されるインターフェース回路の一実施例の回路図である。

【図 3】

本発明の半導体集積回路装置の内部で映像信号入力用の外部端子が接続されるインターフェース回路の一実施例の回路図である。

【図 4】

本発明の半導体集積回路装置の外部端子の等価回路図である。

【図 5】

外部端子間のクロストークの特性図である。

【図 6】

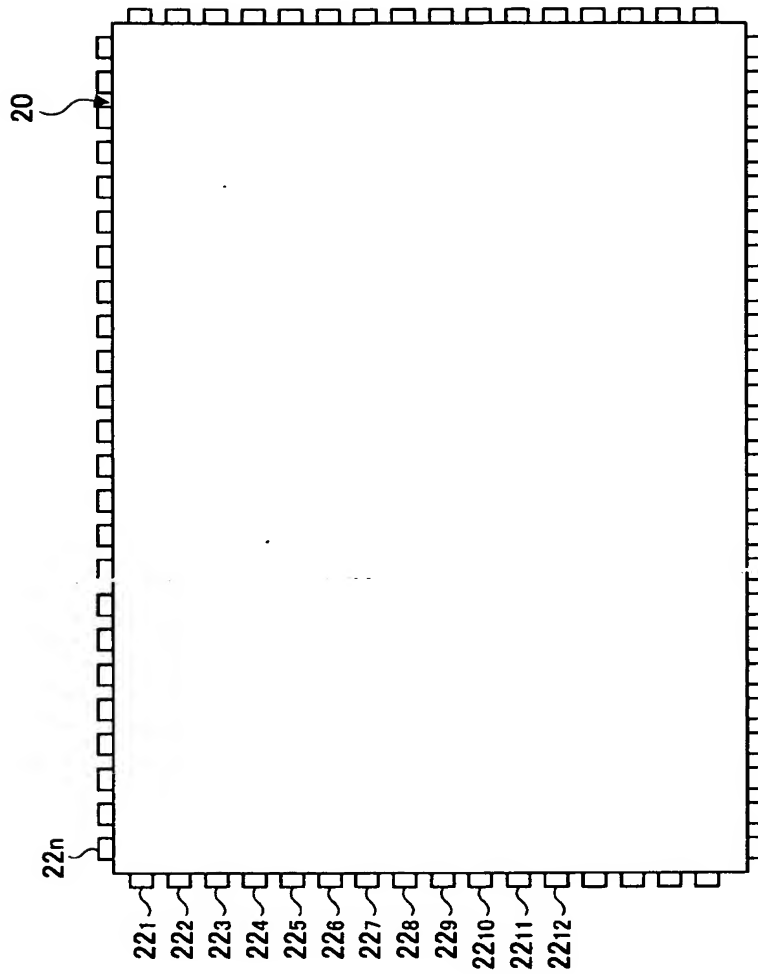
従来の半導体集積回路装置の一例の平面図である。

【符号の説明】

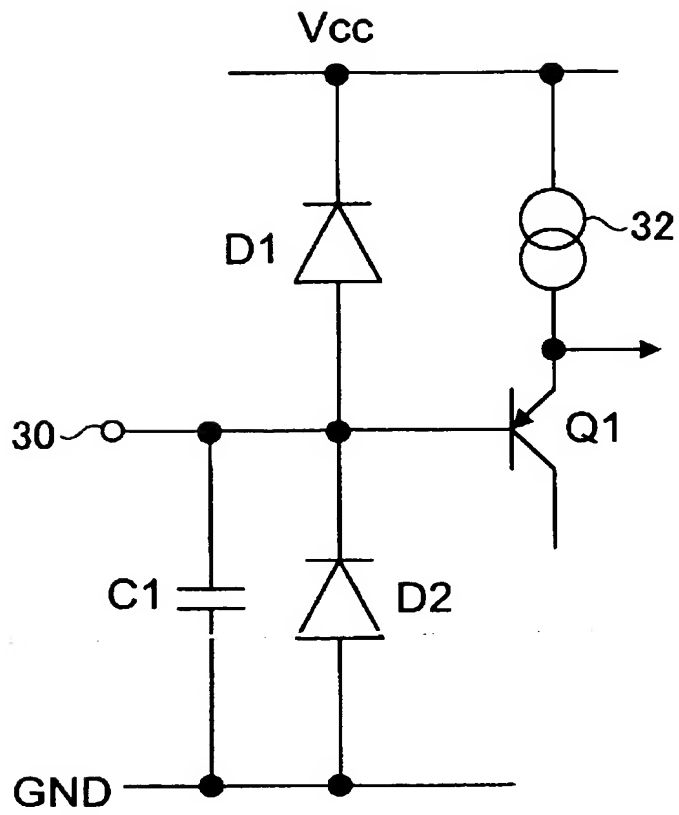
20 半導体集積回路装置本体
22₁～22_n, 30 外部端子
32, 42 定電流源
C1 コンデンサ
D1～D12 ダイオード
Q1～Q13 トランジスタ
R1～R4 抵抗

【書類名】 図面

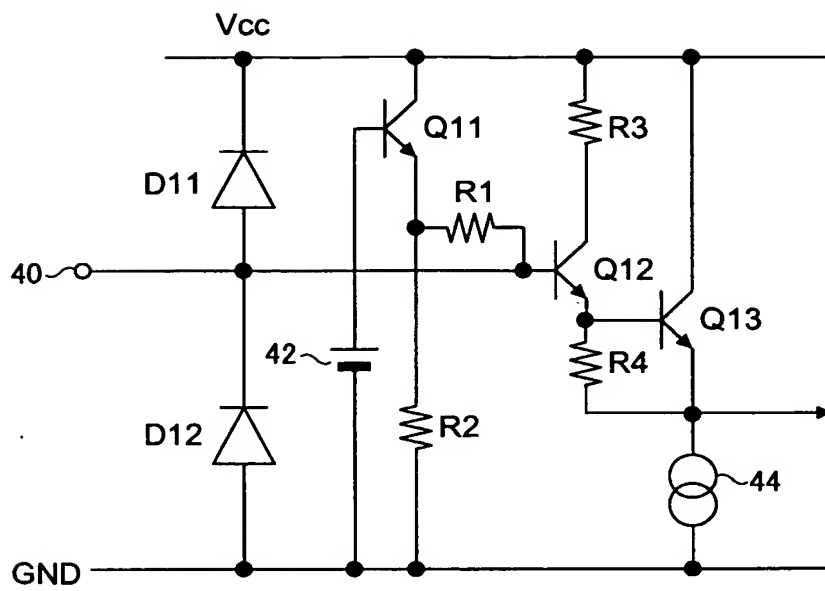
【図 1】



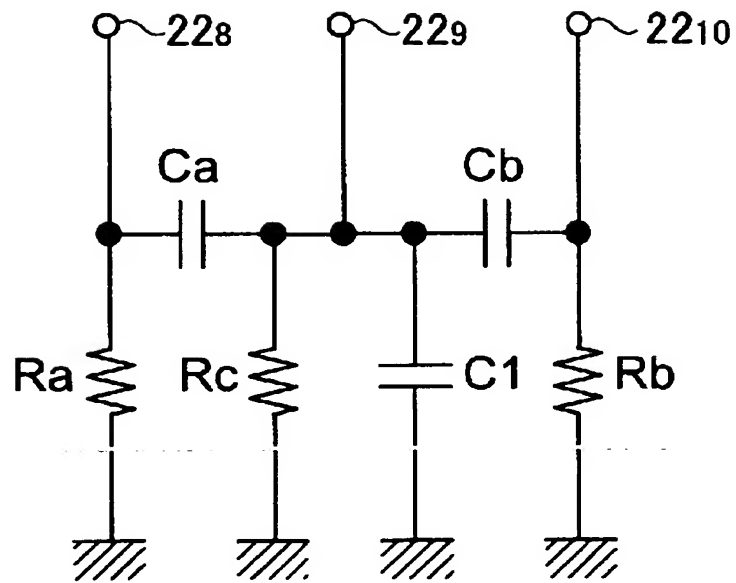
【図 2】



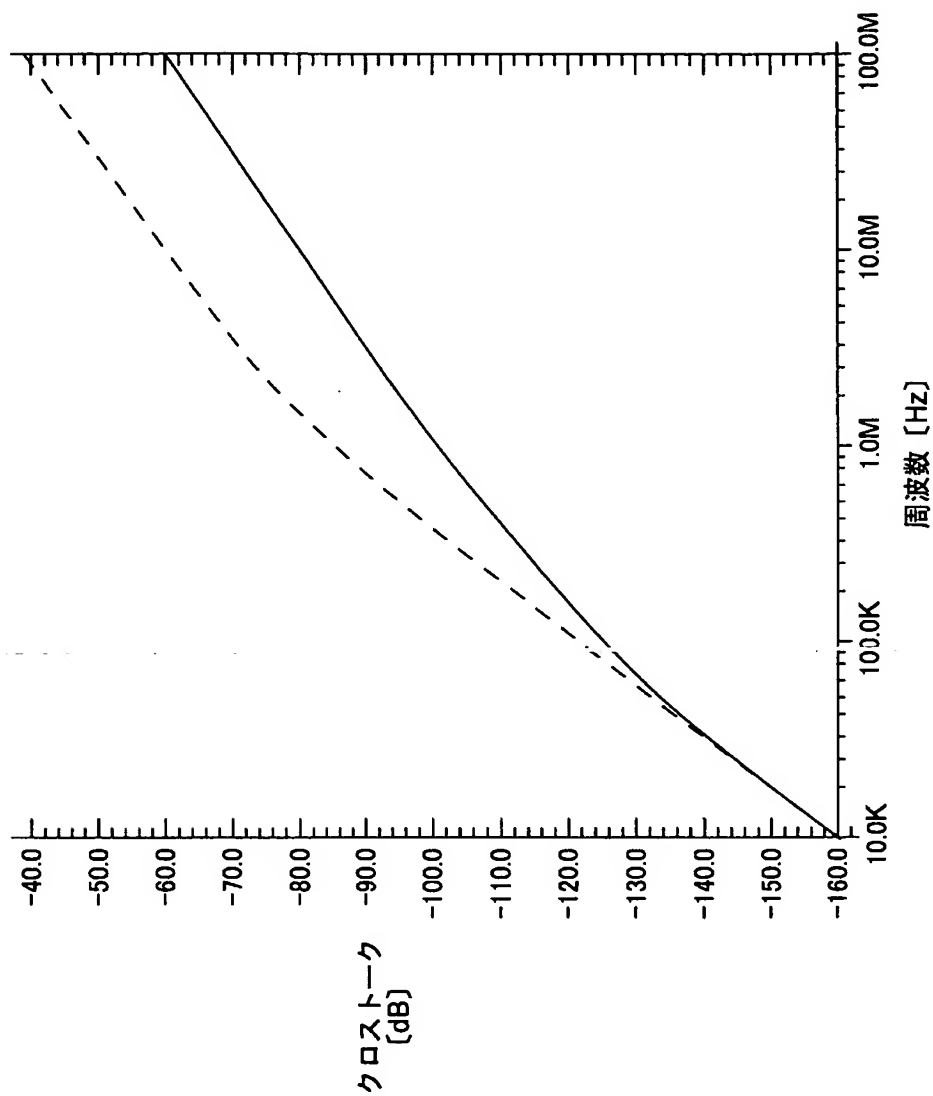
【図 3】



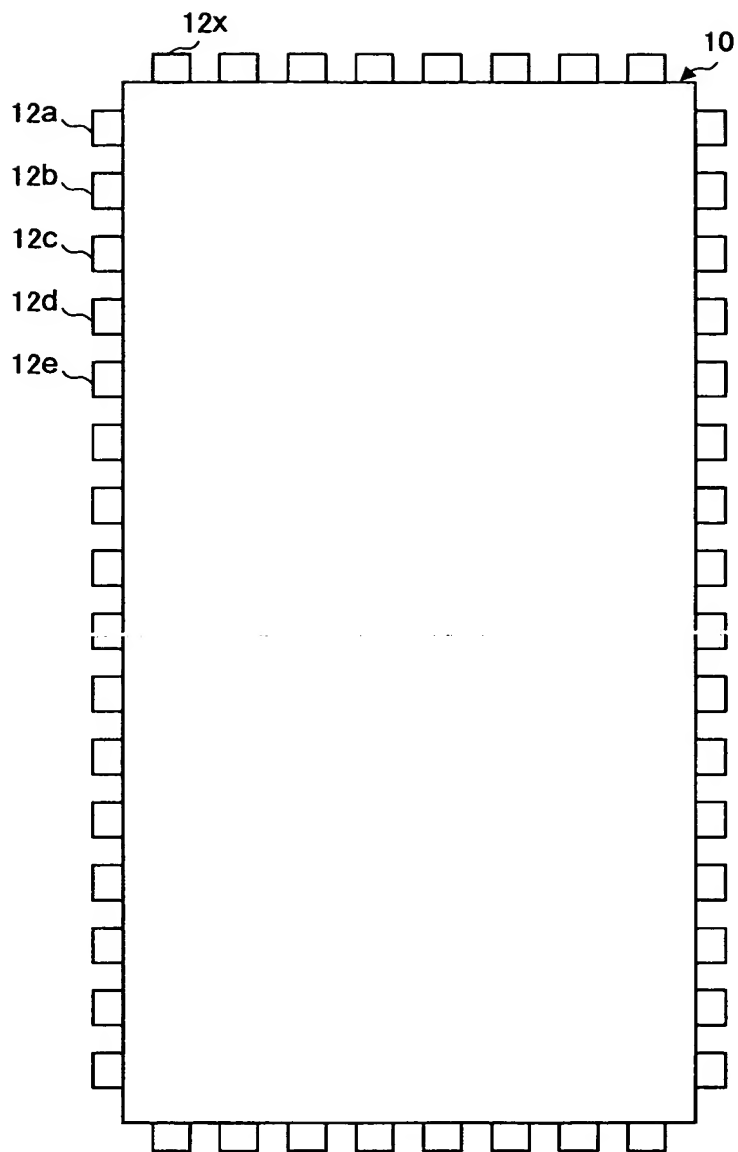
【図 4】



【図 5】



【図 6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は、低インピーダンスの外部端子数を増加することなくクロストークを低減できる半導体集積回路装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 複数系統の高周波信号を入出力する半導体集積回路装置において、高周波信号を入出力する第1外部端子222, 224, 226, 228, 2210, 2212の間に前記第1外部端子222, 224, 226, 228, 2210, 2212より高インピーダンスの第2外部端子225, 227, 229, 2211を配置し、前記第2外部端子225, 227, 229, 2211に一端を接続され他端を所定電位とされた容量素子を設け構成する。

【選択図】 図4



特願 2 0 0 3 - 1 7 4 7 4 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 6 2 2 0]

1. 変更年月日

2 0 0 3 年 1 月 7 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都多摩市鶴牧2丁目11番地2

氏 名

ミツミ電機株式会社